

- Пн 2-10с** *М. С. Аксенов, А. Ю. Широков, В. А. Голяшов,
С. Е. Хандархаева, А. К. Гутаковский, А. В. Бакулин,
С. Е. Кулькова, Н. А. Валишева, О. Е. Терещенко*
Пассивация поверхности InAs фтором при сухом окислении в таунсендовском разряде
- Пн 2-11с** *М. В. Гомоюнова, Г. С. Гребенюк, И. И. Пронин*
Формирование ферромагнитных пленок силицида кобальта Co₃Si на поверхности монокристаллического кремния
- Пн 2-12с** *Н. А. Тулина, А. Н. Россоленко, И. М. Шмытько,
Н. Н. Колесников, Д. Н. Борисенко, В. В. Сироткин,
И. Ю. Борисенко*
Получение и исследование мезоскопических гетероструктур на основе селенида висмута Bi₂Se₃
- Пн 2-13с** *Е. В. Гущина, О. А. Маслова, J. Alvarez, W. Favre,
R. Varache, M. E. Gueunier-Farret, A. С. Гудовских,
А. В. Анкудинов, Е. И. Теруков, J. P. Kleider*
Изучение границы а-Si:H/c-Si на сколах гетероструктур с помощью сканирующей зондовой микроскопии
- Пн 2-14с** *Т. В. Павлова, Г. М. Жидомиров, К. Н. Ельцов*
Динамика гетерогенной химической реакции хлорирования Cu(111)
- Пн 2-15с** *М. В. Лебедев*
Модификация поверхности полупроводников A³B⁵ посредством зарядового обмена на границе с раствором
- Пн 2-16с** *С. Б. Бодров, А. А. Мурзанев, Ю. А. Мальков,
Ю. А. Сергеев, А. Н. Степанов, Д. А. Ящунин*
Исследование генерации второй гармоники оптического излучения с поверхности металла при воздействии мощного терагерцового поля
- Пн 2-17с** *В. Б. Шмагин, К. Е. Кудрявцев, Д. В. Шенгуров,
З. Ф. Красильник*
Поглощение Урбаха и флуктуации зонного потенциала в эпитаксиальных слоях Si:Er
- Пн 2-18с** *Д. М. Казанцев, И. О. Ахундов, Н. Л. Шварц,
В. Л. Альперович, А. С. Терехов, А. В. Латышев*
Выглаживание и разупорядочение ступенчато-террасированной поверхности GaAs: эксперимент и Монте-Карло моделирование